

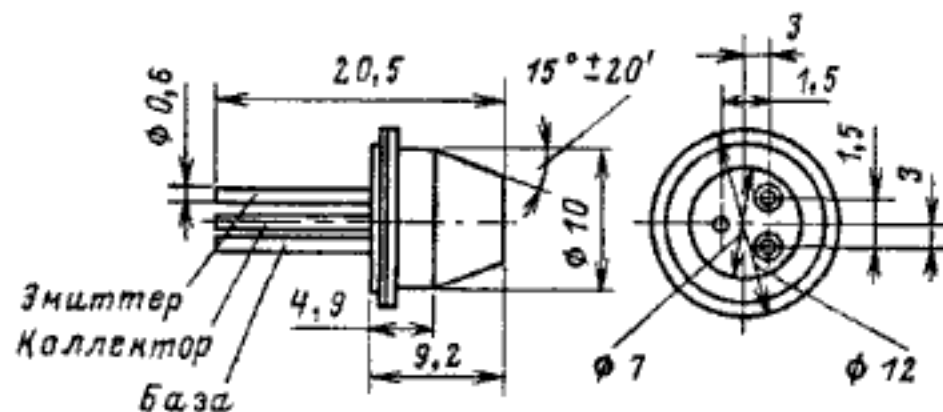
**1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д,
1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б,
ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж,
ГТ403И, ГТ403Ю**

Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* усилительные низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах переключения, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабилизаторах постоянного тока.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 4 г.



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А не более	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,05$ А не более	0,8 В
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 0,1$ А, $f = 50 \div 300$ Гц:	
1Т403А, 1Т403В, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403В, ГТ403Ж	20 – 60
1Т403Б, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Б, ГТ403Г, ГТ403Д	50 – 150
ГТ403Ю	30 – 60
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_Э = 0,45$ А 1Т403Е, ГТ403Е, 1Т403И, ГТ403И не менее	30
Изменение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Ж при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 0,1$ А, $f = 50 \div 300$ Гц не более:	
при $T = 343$ К	$\pm 30\%$
при $T = 213$ К	-50%

Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 1Т403Е, 1Т403И при $U_{КБ} = 1$ В, $I_Э = 0,45$ А не более	
при $T = 343$ К	$\pm 30\%$
при $T = 213$ К	$+50\%$, -40%
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 0,1$ А не менее	8 кГц
Плавающее напряжение эмиттер-база при $U_{КБ} = 45$ В 1Т403А, 1Т403Б, при $U_{КБ} = 60$ В 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, при $U_{КБ} = 80$ В 1Т403Ж, 1Т403И при $T = 343$ К не более	0,3 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ\text{ макс}}$ не более	
при $T = 298$ К	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
при $T = 343$ К	800 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 20$ В 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Е, ГТ403Ю, $U_{БЭ} = 30$ В 1Т403Д, ГТ403Д не более	
при $T = 298$ К	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	50 мкА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	70 мкА
при $T = 343$ К	800 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ\text{ макс}}$	
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ю	5 мА
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И	6 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер

1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю 30 В

1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е, 1Т403Г, 1Т403Д,
ГТ403Г, ГТ403Д 45 В

1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И 60 В

Постоянное напряжение коллектор-база

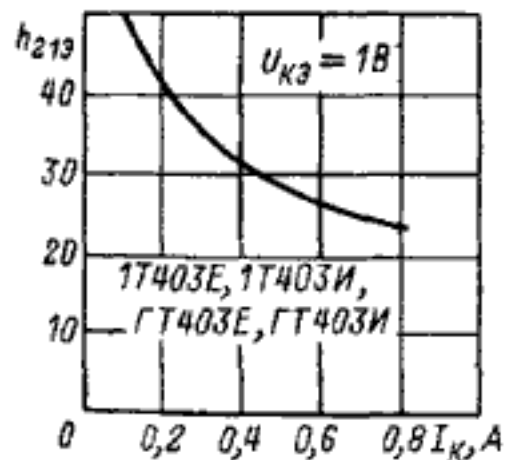
1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю 45 В

1Т403В, 1Т403Е, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403В, ГТ403Е,
ГТ403Г, ГТ403Д 60 В

1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И 80 В

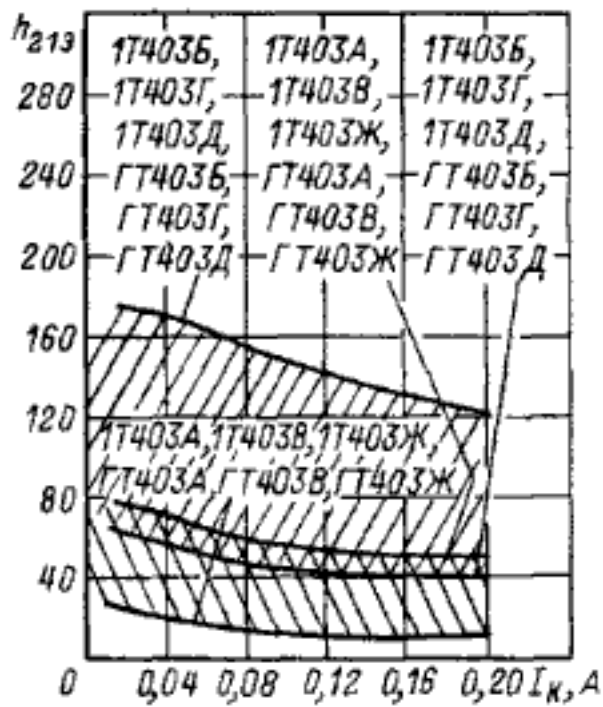
Постоянное напряжение эмиттер-база	20 В
1Т403Д, ГТ403Д	30 В
Постоянный ток коллектора	1,25 А
Постоянный ток базы	0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
с теплоотводом	$(358 - T_K)/R_{T \text{ п-к}}$ Вт
без теплоотвода	$(358 - T)/R_{T \text{ п-с}}$ Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус	15 К/Вт
1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е	12 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда	100 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	
1Т403	От 213 до 343 К
ГТ403	От 218 до 343 К

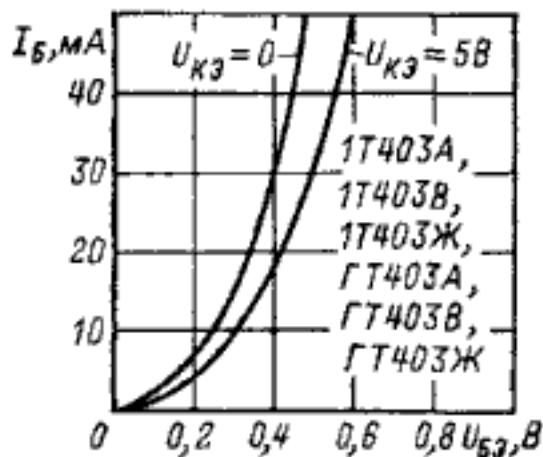
Примечание Разрешается производить изгиб и пайку выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с температурой жала паяльника не более 533 К в течение 3 с и групповым или механизированным способом при температуре припоя не более 533 К в течение 5 с



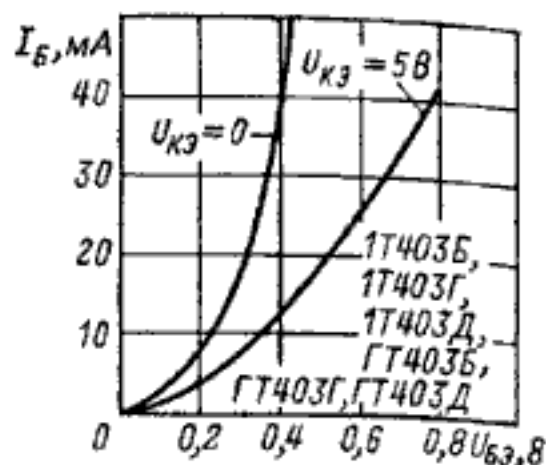
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

Зона возможных положений зависимости статического коэффициента тока от тока коллектора.

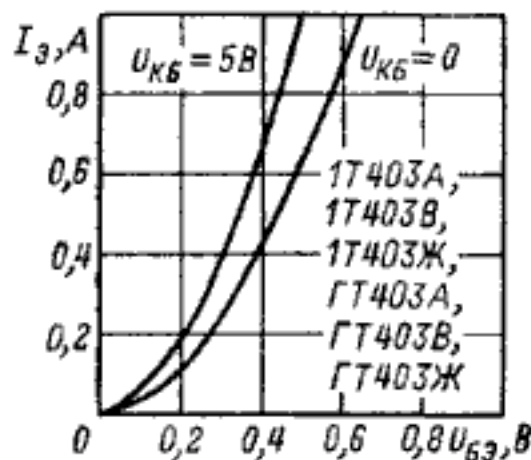




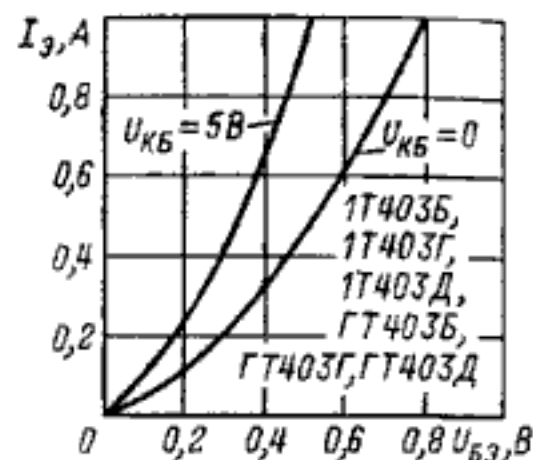
Входные характеристики



Входные характеристики



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер